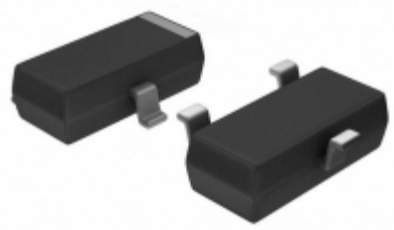




	<p>FDN359BN</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN359BN</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3</p>
	<p>Datenblätter: 1.FDN359BN.pdf 2.FDN359BN.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
<p>Lagerzustand: New original, 150490 pcs Stock Available.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDN359BN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	150490 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.7A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN359BN-ND

FDN359BN ist neu im Original, Suche FDN359BN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN359BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN359BN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN359BN-NL GC FDN359BN-NL GC</p>	 <p>FDN360 HAM FDN360 HAM</p>	 <p>FDN359N-NL FAIRCHILD FDN359N-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDN359BN_F095 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3</p>
 <p>FDN359AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>	 <p>FDN359BN FDK America MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT</p>	 <p>FDN359AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>	 <p>FDN359AN-NL FSC/PL FDN359AN-NL FSC/PL</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDN338P-NL	↔ FDN338P-NL/338	⇒ FDN339AN	D FDN339AN	↔ FDN339AN-NL
⊣ FDN339N-NL	⊛ FDN340P-NL	D FDN342P-NL	⇒ FDN352AP	↔ FDN352AP
⊛ FDN352AP-NL	⊣ FDN352P-NL	⊛ FDN355A-NL	↔ FDN355N-NL	↔ FDN356AP-NL
D FDN356P-NL	⊛ FDN357N-NL	⊣ FDN357NNL	⊛ FDN357P-NL	↔ FDN358P-NL
⇒ FDN359AN	↔ FDN359AN	⊛ FDN359AN-NL	⊣ FDN359BN	↔ FDN359BN
↔ FDN359BN-NL	⇒ FDN359N-NL	D FDN360P-NL	⊛ FDN360P-NL/360	⊣ FDN361AN
⊛ FDN361AN	D FDN361AN-NL	⇒ FDN361BN	↔ FDN361BN	↔ FDN361BN-NL
⊣ FDN362AN-NL	⊛ FDN363N-NL	↔ FDN371N-NL	⇒ FDN372S-NL	↔ FDN5330SX
⊛ FDN537N-NL	⊣ FDN5618P	⊛ FDN5618P	D FDN5618P-NL	↔ FDN5630-NL
↔ FDN5630N-NL	⊛ FDN5630_NL	⊣ FDN5632-NL	⊛ FDN5632N	↔ FDN5632N-F085

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

